

<http://physicsweb.org/article/news/8/7/13>

2004/07/23

## يونيدن - اتم‌ها با إس‌تى‌إم

پژوهش‌گران‌ی از آزمایش‌گاه - پژوهشی‌ی آئی‌بی‌ام [1] در زوریخ و دانش‌گاه - کالیرس/یتیبری [2] در سوئد، توانستند با استفاده از میکروسکپ - تونلی‌ی رویشی (إس‌تى‌إم) [3] به تک‌اتم‌ها‌ی طلاتک‌الکترون بدهند یا از تک‌اتم‌ها‌ی طلاتک‌الکترون بکنند. شاید این روش نهایتاً به ابزارهای حافظه‌ای بینجامد که هر بیت را روی فقط یک اتم ذخیره می‌کنند [4].

یاشا رپ [5] از آئی‌بی‌ام می‌گوید: "در 1990، دان ایگلر [6] از مرکز - پژوهشی‌ی الوبیدن [7] - آئی‌بی‌ام نشان داد با استفاده از إس‌تى‌إم می‌شود اتم‌ها را با دقت - اتمی روی یک سطح گذاشت. حالا قدم - بعدی را برداشته اند: دست‌کاری‌ی حالت‌بار - یک اتم بدون - بردن - ش به یک جای‌گاوجذب - دیگر و بدون - تغییردادن - محیط - شیمیایی یَش." رپ و هم‌کاران - ش یک إس‌تى‌إم - خانه‌گی به کار برداند، که نُک - آن یک سیم - تنگستنی‌ی الکتروشیمیایی‌سونیده بود، و این دست‌گاه را در دمایا بین - 5 تا 60 کلوین به کار‌انداختند. آن‌ها اتم‌ها‌ی طلا را روی یک لایه‌ی نارسانا‌ی سدیم کلرید (به کلفتی‌ی فقط دویا سه لایه‌ی اتمی) برآشامیدند. این لایه‌روی یک تک‌بلور - مس بود. اتم‌ها‌ی برآشامیده روی یون‌ها‌ی  $\text{Cl}^-$  قرار گرفتند.

این پژوهش‌گران، برا ی تغییردادن - حالت‌بار - یک اتم - طلا فقط با استفاده از نُک - إس‌تى‌إم به آن یک تَپ - ولتاژ اعمال کردند. اعمال - یک ولتاژ - 0.6 ولت به مدت - چند ثانیه، باعث شد جریان - تونلی‌به اندازه‌ی حدوداً یک سه‌وم کاهش یابد. ضمناً تصویر - اتم - برآشامیده هم به شکل - یک کلاه - اسپانیایی درآمد، با قله‌ای به ارتفاع - حدوداً 0.5 آنگسترم کمتر از پیش ولبه‌ای که دور - آن ظاهر شده بود. با اعمال - یک ولتاژ - منفی به اندازه‌ی حدوداً 1 - ولت، اتم - برآشامیده به حالت - اولیه برگشت.

از این آزمایش‌ها بر می‌آید اتم‌های طلا ی برآشامیده اول در حالت خنثا بوده‌اند و با اعمال یک ولتاژ مشبت بار منفی یافته‌اند. رپ گفت: «ویژه‌گی‌ها ی فیزیکی و شیمیایی ی یون‌ها، عموماً با ویژه‌گی‌ها ی متناظر اتم‌های خنثا ی متناظر تفاوت کیفی دارد. به همین خاطر یافته‌ها ی مانه تنها برا ی فیزیک که برا ی شیمی هم مهم است.»

رپ می‌گوید نشاندن و برداشتن کنترل شده ی یک بار الکترون بر واژیک تک‌اتم، گامی تعیین‌کننده به سوی دست‌گاه‌ها ی تام‌مقیاس‌اتمی کوچک آینده است. او توضیح داد: «مثلاً شاید به یک یاخته‌ی حافظه ی پایدار در حد اعلا ی کوچکی ی فضایی برسیم، چنان که هربیت اطلاعات در یک تک‌اتم ذخیره شود. با حافظه‌ها ی کاربردی ی مقیاس‌اتمی، مقدار داده ی قابل‌ذخیره بر مساحت را می‌شود دست‌کم ده هزار برابر کرد.»

ضمیناً شاید با این روش بشود ویژه‌گی‌ها ی مواد در مقیاس اتمی را هم کنترل کرد. رپ گفت: «با تبدیل حالت‌های بار مختلف یک تک‌اتم به هم، می‌شود مثلاً واکنش‌پذیری ی شیمیایی، ویژه‌گی‌ها ی اپتیکی، یا دوقطبی ی مغناطیسی ی اتم را کنترل کرد. به خاطر دوربرد بودن نیروها ی الکتروستاتیک، شاید حتاً ویژه‌گی‌ها ی ملکول‌ها را هم بشود از طریق تغییردادن حالت‌بار یک اتم نزدیک کنترل کرد.»

هدف این پژوهش‌گران سویسی-سوئی مطالعه ی جریان الکترون از ساختارها ی اتمی ی ساخت‌انسانی است که از نظر الکترونی از یک زیرلایه ی فلزی واجفتیده‌اند و تا مقیاس‌های طول اتمی دقیقاً مرتب شده‌اند. رپ گفت: «برا ی رسیدن به این هدف نشاندن عرضی ی کنترل شده ی اتم‌ها و ملکول‌ها ی بزرگ‌تر بر لایه‌ها ی فرانازک نارسانا را بررسی می‌کنیم. می‌خواهیم با کنترل حالت‌بار تک‌اتم‌ها اجتماع چنین ساختارها ی مقیاس‌اتمی یی و گذشتمن جریان‌ها ی الکترونی از درون آن‌ها را کنترل کنیم.»

- [1] IBM
- [2] Chalmers/Göteborg
- [3] scanning tunnelling microscope (STM)
- [4] Science **305** 493
- [5] Don Eigler
- [6] Almaden Research Center
- [7] Jascha Repp